

12

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

22 Date de dépôt : 03.09.10.

30 Priorité :

43 Date de mise à la disposition du public de la
demande : 09.03.12 Bulletin 12/10.

56 Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du
présent fascicule*

60 Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

71 Demandeur(s) : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATO-
MIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablis-
sement public — FR.

72 Inventeur(s) : DEFAY EMMANUEL, LE RHUN GWE-
NAEL et SUHM AURELIEN.

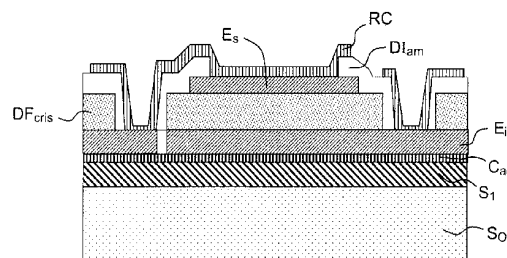
73 Titulaire(s) : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMI-
QUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Etablis-
sement public.

74 Mandataire(s) : MARKS & CLERK FRANCE.

54 CAPACITÉ INTÉGRÉE COMPRENANT UNE COUCHE D'ISOLATION ÉLECTRIQUE EN MATÉRIAU DE TYPE
PEROVSKITE AMORPHE ET PROCÉDÉ DE FABRICATION.

57 L'invention concerne une capacité intégrée comprenant une couche de matériau diélectrique dit fonctionnel (DF_{cris}) à base de matériau cristallisé de type pérovskite, comprise entre au moins une première électrode dite inférieure (Ei) à la surface d'un substrat et au moins d'une deuxième électrode dite supérieure (Es), lesdites électrodes étant isolées électriquement par une couche de matériau isolant électrique pour permettre au moins une reprise de contact sur l'électrode supérieure, caractérisée en ce que le matériau isolant électrique est en matériau diélectrique amorphe de type pérovskite (DI_{am}) présentant une constante diélectrique inférieure à celle du matériau cristallisé de type pérovskite.

L'invention a aussi pour objet un procédé de fabrication d'une telle capacité intégrée.



Capacité intégrée comprenant une couche d'isolation électrique en matériau de type pérovskite amorphe et procédé de fabrication.

Le domaine de l'invention est celui des composants de type capacité intégrée comprenant une couche de diélectrique comprise entre une électrode supérieure et une électrode inférieure et avec reprise de contact, nécessitant l'utilisation d'isolant électrique entre les deux types d'électrodes.

5 Typiquement ce type de composant peut être utilisé dans le cadre d'actionneurs piézoélectriques, notamment pour l'optique adaptative ou des actionneurs pour imprimantes à jet d'encre. De tels composants peuvent également être utilisés pour réaliser des résonateurs et des filtres radio-
10 fréquences acoustiques utilisant un effet piézoélectrique pour la téléphonie mobile. Ils sont également intéressants pour l'élaboration de capacités variables ferroélectriques, de capacités à très fortes valeurs utilisées pour la téléphonie mobile ou les objets nomades en général (pacemaker, objets communicants).

Actuellement pour réaliser des capacités intégrées en technologie
15 plane (appelée MIM pour Métal Isolant Métal), on a besoin de reprendre les contacts électriques sur les électrodes. En effet, une structure typique de capacité MIM comporte une couche de diélectrique dit fonctionnel DF en sandwich entre deux électrodes Es et Ei, l'électrode inférieure étant à la surface d'un substrat S recouvert d'une couche isolante Ci comme illustré en
20 figure 1.

Pour reprendre les contacts via une couche de reprise de contacts RC_{sup} et RC_{inf} , et pour éviter le court circuit entre les électrodes supérieure et inférieure, il est nécessaire d'utiliser un diélectrique d'isolation DI comme illustré sur la figure 2.

25 Ce diélectrique d'isolation peut être un oxyde de silicium SiO_2 déposé par PECVD, par pulvérisation, ou par un dépôt à la tournette couramment identifié par l'acronyme « SOG » pour « Spin On Glass » par exemple. Cela peut être aussi un nitrure de silicium Si_xN_y déposé par PECVD, LPCVD par exemple, il pourrait tout aussi bien s'agir d'autres
30 matériaux isolants tels que les composés suivants : Ta_2O_5 , Al_2O_3 , MgO , AlN ...

Une contrainte pour ce diélectrique d'isolation DI est qu'il ne doit pas perturber le fonctionnement du diélectrique fonctionnel DF. En particulier, il

est important que la capacité qu'il rajoute en parallèle sur le dispositif soit négligeable par rapport à la capacité fonctionnelle. Pour ce faire, l'état de l'art utilise un diélectrique d'isolation DI de constante diélectrique faible par rapport au diélectrique fonctionnel DF.

5 Par exemple, si le diélectrique fonctionnel DF est du $\text{Pb}(\text{Zr,Ti})\text{O}_3$ (PZT) dont la constante diélectrique vaut typiquement 1000, il est courant d'utiliser un oxyde de silicium comme diélectrique d'isolation DI dont la constante diélectrique vaut 4. Ainsi, la capacité ajoutée par le SiO_2 sera beaucoup plus faible que la capacité de PZT, à surface équivalente donnée.

10 Pour le PZT et autres oxydes à très forte permittivité, l'utilisation du diélectrique d'isolation DI peut poser un problème de fiabilité. En effet, Bouyssou et al. (thèse Emilien Bouyssou, p.20, thèse de l'Université de Tours, 2006), ont observé que le SiO_2 utilisé comme diélectrique d'isolation DI est à l'origine de l'apparition d'une fragilité dans des capacités de PZT,
15 plus précisément d'un vieillissement prématuré des condensateurs en test de contrainte en tension constante. Ceci est expliqué par les composés hydrogénés utilisés lors des dépôts CVD des diélectriques d'isolation DI, méthode la plus couramment utilisée dans l'industrie et notamment illustré en figure 3, recouvert d'une couche USG (pour « Undoped Silicon Glass) avec
20 reprise de contact Rc.

Dans ce contexte, la présente invention a pour objet un composant de type capacité intégrée utilisant un diélectrique d'isolation électrique ne présentant pas les inconvénients précités et dont le procédé de fabrication s'avère être particulièrement intéressant.

25 Plus précisément la présente invention a pour objet une capacité intégrée comprenant une couche de matériau diélectrique dit fonctionnel à base de matériau cristallisé de type pérovskite, comprise entre au moins une première électrode dite inférieure à la surface d'un substrat et au moins d'une deuxième électrode dite supérieure, lesdites électrodes étant isolées
30 électriquement par une couche de matériau isolant électrique pour permettre au moins une reprise de contact sur l'électrode supérieure, caractérisée en ce que le matériau isolant électrique est en matériau diélectrique amorphe de type pérovskite présentant une constante diélectrique inférieure à celle du matériau cristallisé de type pérovskite.

On entend par « matériau de type pérovskite », un matériau de même composition chimique qu'un matériau de structure cristalline pérovskite .

Selon une variante de l'invention, le matériau isolant électrique est
5 disposé sur ou sous l'électrode supérieure.

Dans le cas où l'isolant est disposé sous l'électrode supérieure, cette dernière peut jouer le rôle d'électrode et de reprise de contact.

Selon une variante de l'invention, le matériau diélectrique fonctionnel cristallisé est un oxyde parmi les oxydes suivants : $\text{Pb}(\text{Sr},\text{Ti})\text{O}_3$, SrTiO_3 ,
10 $(\text{Ba},\text{Sr})\text{TiO}_3$, $(\text{Pb},\text{La})(\text{Zr},\text{Ti})\text{O}_3$, $\text{Pb}(\text{Mg},\text{Nb},\text{Ti})\text{O}_3$, $\text{Pb}(\text{Zn},\text{Nb},\text{Ti})\text{O}_3$, BiFeO_3 , BaTiO_3 .

Selon une variante de l'invention, le matériau diélectrique isolant électrique amorphe est un oxyde parmi les oxydes suivants : PZT, SrTiO_3 ,
(Ba,Sr) TiO_3 , (Pb,La)(Zr,Ti) O_3 , $\text{Pb}(\text{Mg},\text{Nb},\text{Ti})\text{O}_3$, $\text{Pb}(\text{Zn},\text{Nb},\text{Ti})\text{O}_3$, BiFeO_3 ,
15 BaTiO_3 .

Selon une variante de l'invention, les électrodes sont en platine ou en ruthénium, ou en oxyde de ruthénium, ou en iridium, ou en oxyde d'iridium, ou en or.

Selon une variante de l'invention, le substrat est en silicium et
20 comporte une couche supérieure d'oxyde.

Selon une variante de l'invention, la capacité en outre une couche d'accrochage entre le substrat et la couche d'électrode inférieure.

Selon une variante de l'invention, la reprise de contact est formée à partir d'une couche de reprise de contact gravée, disposée au dessus de la
25 couche de diélectrique isolant électrique et de l'électrode supérieure.

L'invention a aussi pour objet un procédé de fabrication d'une capacité intégrée selon l'invention, caractérisé en ce qu'il comprend au moins une étape de réalisation d'une couche de matériau diélectrique amorphe et isolant électrique, au dessus ou au dessous de l'électrode
30 supérieure, par procédé sol-gel comportant :

- l'étalement d'une solution sol-gel ;
- le séchage de ladite solution à une température comprise entre environ 100°C et 150°C ;

- la pyrolyse de ladite solution séchée à une température comprise entre environ 300°C et 500°C conduisant au matériau diélectrique isolant amorphe.

Selon une variante de l'invention, le procédé comprend au moins une
5 étape de réalisation d'une couche de matériau diélectrique fonctionnel cristallisé entre l'électrode inférieure et l'électrode supérieure par procédé sol-gel comportant :

- l'étalement d'une solution sol-gel à la surface d'un substrat comportant une électrode inférieure ;
- 10 - le séchage de ladite solution à une température comprise entre environ 100°C et 150°C ;
- la pyrolyse de ladite solution séchée à une température comprise entre environ 300°C et 500°C conduisant à un matériau diélectrique fonctionnel amorphe;
- 15 - la cristallisation dudit matériau fonctionnel amorphe porté à une température supérieure ou égale à la température de cristallisation dudit matériau de manière à obtenir le matériau diélectrique fonctionnel cristallisé.

Selon une variante de l'invention, la cristallisation est effectuée par
20 recuit rapide (RTA).

L'invention sera mieux comprise et d'autres avantages apparaîtront à la lecture de la description qui va suivre donnée à titre non limitatif et grâce aux figures annexées parmi lesquelles :

- 25 - la figure 1 illustre un exemple de structure capacité MIM selon l'art connu ;
- la figure 2 illustre un exemple d'utilisation d'un diélectrique d'isolation pour reprendre les contacts sur la capacité MIM selon l'art connu ;
- 30 - la figure 3 illustre l'apparition de défauts dans le PZT, dus à la présence d'hydrogène dans un verre non dopé de silice ;
- les figures 4a et 4b illustrent deux exemples de procédés d'étalement de type sol-gel sur un substrat par enduction centrifuge et par trempage-retrait ;

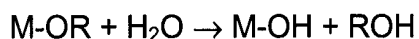
- les figures 5a et 5b illustrent un exemple d'empilement pour une capacité à forte permittivité selon l'invention avec électrode inférieure non gravée ou gravée ;
- les étapes 6a à 6k illustrent les différentes étapes d'un procédé de fabrication d'une capacité intégrée selon l'invention.

Selon l'invention, il est proposé d'utiliser un procédé sol-gel permettant de réaliser des composants présentant une couche diélectrique de forte permittivité et une couche de matériau de couche ayant une permittivité plus faible assurant une fonction d'isolation électrique entre les deux types d'électrodes dite inférieure et supérieure.

Dans le cas de matériaux à très forte permittivité, une technique connue est le procédé sol gel et notamment de type polymérisation sol-gel. Le dépôt par voie sol-gel de PbTiO_3 (PT) a été rapporté pour la première fois en 1984 par GURKOVICH S. R., Blum J. B., *Preparation of monolithic lead-titanate by sol-gel process, in Ultrastructure Processing of Ceramics, Glasses and Composites*, L.L.Ha.D.R. Ulrich, Editor, Wiley-Interscience: New-York, 152-160, 1984.

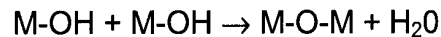
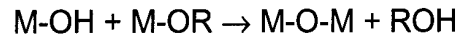
L'année suivante, Budd ans al. BUDD K. D., Dey S. K., PAYNE D. A., *Sol-gel processing of PT, PZ, PZT and PLZT thin films*. Br. Ceram. Proc. 107-121, 1985, ont décrit la synthèse de films minces pérovskites à base de plomb (PT, PZ, PZT, PLZT)]. Ce procédé utilise une solution contenant des précurseurs réactifs tels que les sels métalliques ou les alcoxydes, et un solvant. Le dépôt des couches minces peut se faire par enduction centrifuge (spin-coating) ou bien par trempage-retrait (dip-coating) comme illustré sur les figures 4a et 4b.

Le principe du procédé sol-gel repose sur une succession de réactions d'hydrolyse-condensation, à une température proche de l'ambiante, qui conduit à la formation d'un polymère minéral, lequel peut ensuite être traité thermiquement. L'étape d'hydrolyse des alcoxydes métalliques est schématisée par la réaction suivante :

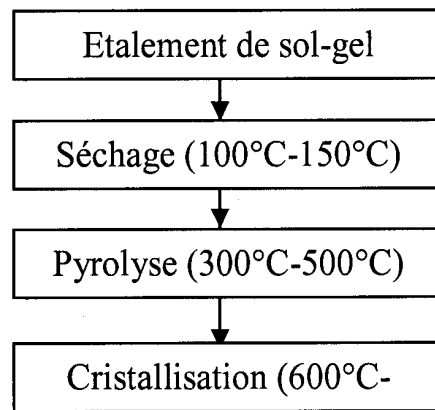


où M est un cation métallique, et R un groupe organique alkyl. Cette réaction permet la conversion des fonctions alcoxy en fonction hydroxy. La solution

obtenue est appelée *sol* ; c'est-à-dire une phase solide, constituée de petites entités, dispersée dans un liquide (le solvant). Les fonctions hydroxy sont ensuite converties en espèces M-O-M correspondant à la formation d'un réseau macromoléculaire minéral constituant le *gel*. Cela se fait suivant
 5 plusieurs réactions de condensation (formation de ponts oxo, -O-, par réactions d'oxolation) avec élimination d'alcool et d'eau.



La réalisation des films piézoélectriques par la technique sol-gel
 10 consiste en une succession d'étapes d'étalement de la solution sol-gel et de traitements thermiques, comme schématisé ci-après :



15 La solution est habituellement étalée sur un substrat par enduction centrifuge. L'épaisseur de film déposée dépend principalement de la vitesse de rotation de la tournette et des paramètres physico-chimiques de la solution (viscosité, concentration, taux d'évaporation). Une étape de séchage permet d'évaporer une partie des solvants et d'obtenir un dépôt solide. La
 20 couche subit ensuite une pyrolyse (ou calcination) afin d'éliminer les résidus organiques.

Cette étape, généralement effectuée sur plaque chauffante, est cruciale car elle conditionne grandement la qualité structurale du film piézoélectrique. La température de calcination doit être suffisamment élevée
 25 afin d'éliminer la totalité des résidus organiques (typiquement comprise entre 300°C et 450°C). Dans le cas contraire, le piégeage de matière organique peut conduire à la présence de porosités. Cependant, une température trop élevée risque de favoriser l'apparition de phase parasite, comme la

pyrochlore dans le cas du PZ, décrit dans la publication : GONG W., L J. F., CHU X., LI L., J. Eur. Ceram. Soc. 24, 2977-2982, 2004.

Après pyrolyse, la couche amorphe obtenue est cristallisée et densifiée à une température comprise entre 600°C et 800°C. Cette étape de cristallisation est le plus souvent réalisée par recuit rapide RTA acronyme de l'appellation « Rapid Thermal Annealing », plutôt que par recuit conventionnel, afin notamment de limiter le budget thermique. Le procédé de recuit rapide RTA est aujourd'hui parmi les plus utilisés pour la cristallisation des films minces. Son principal atout est une transmission de l'énergie thermique par rayonnement et non par convection. Il en résulte des montées en température extrêmement rapide pouvant atteindre jusqu'à 300°C/s grâce à l'utilisation de lampes halogènes. Les recuits durent quelques dizaines de secondes. L'épaisseur d'une couche après cristallisation est généralement d'environ 50 nm. Suivant l'épaisseur finale de matériau désirée, il faut répéter à plusieurs reprises l'ensemble des étapes précédemment décrites. Toutefois, l'étape de cristallisation est bien souvent effectuée toutes les deux ou trois couches pyrolysées. On comprend alors l'intérêt d'utiliser le procédé RTA afin de réduire à la fois le budget thermique et le temps de fabrication des films.

Le procédé sol-gel présente l'avantage d'être peu onéreux et relativement simple à mettre en œuvre, ne nécessitant qu'une piste d'étalement, des plaques chauffantes et un four RTA. De plus, il ne requiert pas une maintenance importante, ce qui est un atout non négligeable par rapport aux techniques de dépôt sous vide. Il est par ailleurs très flexible pour le développement de matériaux complexes. On peut ainsi facilement faire varier les compositions par le biais du dosage des précurseurs organo-métalliques, ou bien incorporer des dopants pour optimiser les propriétés des films.

De manière générale, le matériau déposé par procédé sol gel subit plusieurs étapes. Après pyrolyse, le matériau a été débarrassé de tous ses composés organiques (donc H et C). Le matériau résultant est donc exclusivement composé de matières non organiques après cette pyrolyse (parfois appelé calcination). Comme le matériau n'est pas cristallisé, il ne possède pas de constante diélectrique très élevée.

La présente invention propose d'exploiter cette propriété de plus faible constante diélectrique pour utiliser cette couche appelée calcinée ou pyrolysée, comme diélectrique d'isolation DI comme illustré en figure 2. Cela présente l'avantage de permettre d'utiliser un matériau unique comme
5 diélectrique d'isolation DI et diélectrique fonctionnel DF, le diélectrique d'isolation DI ne possède pas de composés hydrogénés susceptibles d'abimer les propriétés du diélectrique fonctionnel DF, la constante diélectrique du diélectrique d'isolation DI reste faible comparée à celle du diélectrique fonctionnel DF (typiquement pour le PZT, la constante
10 diélectrique du PZT calciné non cristallisé se situe entre 20 et 30, alors que la constante diélectrique du PZT cristallisé se situe entre 400 et 1500).

Exemple de procédé de réalisation selon l'invention :

15 La capacité intégrée selon l'invention comprend dans cet exemple un matériau diélectrique fonctionnel de type pérovskite présentant une constante diélectrique élevée pouvant notamment être du PZT et un isolant électrique de type diélectrique de type pérovskite amorphe n'ayant pas subi de phase finale de recuit de cristallisation, entre l'électrode inférieure et
20 l'électrode supérieure, comme illustré en figure 5 qui montre un empilement possible pour une capacité intégrée de très forte valeur utilisant du PZT comme diélectrique d'isolation DI_{am} (calciné) et diélectrique fonctionnel DF_{cris} (cristallisé), à partir d'un substrat S_0 recouvert d'une couche d'oxyde S_1 et d'une couche d'accrochage C_{ac} et comportant une électrode inférieure E_i et
25 une électrode supérieure E_s .

Les différentes étapes du procédé sont décrites ci-après à l'aide des figures 6a à 6k.

Pour réaliser un tel empilement, on peut utiliser un substrat silicium S_0 , typiquement de 200mm de diamètre. On procède à une étape d'oxydation
30 définissant une couche surfacique S_1 de SiO_2 d'épaisseur de 500nm, comme illustré en figure 6a. Cela permet de prévenir les diffusions vers le substrat.

On réalise alors le dépôt d'une couche d'accrochage C_{ac} faite par pulvérisation de 5nm de titane Ti suivi d'une oxydation par recuit rapide de 2 minutes à 750°C sous oxygène O_2 . Cette couche d'accrochage peut être
35 également faite en tantaleTa.

On réalise le dépôt de l'électrode inférieure E_i comme illustré en figure 6b, en Pt (100nm) par pulvérisation. Cette électrode peut également être en iridium. L'électrode inférieure peut ou non être gravée par exemple par usinage ionique selon un motif approprié.

5 On procède à la réalisation du diélectrique fonctionnel en PZT par procédé sol gel comme évoqué selon le schéma réactionnel précédemment décrit, référencé DF_{cris} et illustré en figure 6c. Typiquement, on peut déposer 200 nm de PZT en faisant au moins un dépôt à la tournette, suivi d'une opération de séchage à 110°C durant 5 minutes sur une plaque
10 chauffante, et d'une étape de pyrolyse à 350°C durant 5 minutes sur plaque chauffante. Dans le cas de l'utilisation de dépôt successifs pour obtenir l'épaisseur souhaitée de PZT, chaque dépôt est suivi d'une opération de séchage et de pyrolyse avant le dépôt suivant.

On procède alors à une opération de recuit final de cristallisation à
15 700°C sous air pendant 30 secondes. Généralement ce recuit doit-être réalisé tous les 3 (dépôt/séchage/ pyrolyse) de PZT.

Il est possible d'utiliser d'autres matériaux que le PZT, à très forte permittivité pouvant être notamment l'un des oxydes suivants : $SrTiO_3$, $(Ba,Sr)TiO_3$, $(Pb,La)(Zr,Ti)O_3$, $Pb(Mg,Nb,Ti)O_3$, $Pb(Zn,Nb,Ti)O_3$, $BiFeO_3$,
20 $BaTiO_3$.

Le PZT est ensuite gravé par un procédé dit humide à base de la préparation suivante : HF à 1%, HCl à 37% dans de l'eau et dans les proportions relatives suivantes : 5/ 9/ 50. Cette gravure peut également être faire par gravure sèche en utilisant un équipement de RIE (Reactive Ion
25 Etching) avec des gaz de type chloré avec adjonction d'argon comme illustré en figure 6d. La définition de cette gravure se fait en utilisant préalablement à la gravure une résine photosensible définie par une étape de photolithographie en utilisant un masque dédié.

On procède alors au dépôt par pulvérisation de l'électrode supérieure
30 Es en Pt d'épaisseur typiquement de 100nm comme illustré en figure 6e. Cette électrode peut être tout aussi bien être en ruthénium, ou oxyde de ruthénium, en iridium, ou en oxyde d'iridium, ou bien encore en or. Cette électrode est gravée par usinage ionique. La définition de cette gravure se fait en utilisant préalablement à la gravure une résine photosensible définie
35 par une étape de photolithographie en utilisant un masque dédié.

On dépose ensuite le diélectrique d'isolation par procédé sol gel mais en ne faisant pas l'étape finale de cristallisation, référencé DI_{am} et illustré en figure 6f. Dans ce cas, on utilise du PZT ou d'autres matériaux pouvant notamment être du $SrTiO_3$, $(Ba,Sr)TiO_3$, $(Pb,La)(Zr,Ti)O_3$, $Pb(Mg,Nb,Ti)O_3$, $Pb(Zn,Nb,Ti)O_3$, $BiFeO_3$, $BaTiO_3$). Typiquement l'épaisseur de la couche de diélectrique d'isolation peut avoir une épaisseur de l'ordre de 400nm environ, obtenue par six dépôts calcinés réalisés par dépôts à la tournette, suivis d'une opération de séchage à 110°C pendant 5 minutes sur plaque chauffante, suivie d'une opération de pyrolyse à 350°C durant 5 minutes sur plaque chauffante, réitérée six fois. Il est possible de diminuer ou d'augmenter l'épaisseur en réduisant ou en augmentant le nombre de dépôt (dépôt tournette + séchage à 110°C durant 5 minutes sur plaque chauffante + pyrolyse à 350°C durant 5 minutes sur plaque chauffante) ou la viscosité du liquide sol gel.

Ce diélectrique d'isolation est ensuite gravé par procédé humide à base de la préparation HF 1% - HCl 37% - H_2O dans les proportions 5/9/200 . La définition de cette gravure se fait en utilisant préalablement à la gravure une résine photosensible définie par une étape de photolithographie en utilisant un masque dédié comme illustré en figure 6g.

On dépose ensuite un métal pour faire la reprise de contact R_c comme illustré en figure 6h. Ce métal peut être de manière non limitative de l'Al, de l'Al/Cu, de l'Al/Si, du Cu, du Pt....On peut notamment utiliser un alliage Al/Cu1% sur 1µm d'épaisseur, déposé par pulvérisation.

Cette couche est ensuite gravée par procédé humide ou sec comme illustré en figure 6i. La définition de cette gravure se fait en utilisant préalablement à la gravure une résine photosensible définie par une étape de photolithographie en utilisant un masque dédié.

On dépose enfin une couche isolante de protection I comme illustré en figure 6j, qui est gravée afin d'accéder à la couche de contact R_c comme illustré en figure 6k.

REVENDEICATIONS

1. Capacité intégrée comprenant une couche de matériau diélectrique dit fonctionnel (DF_{cris}) à base de matériau cristallisé de type pérovskite, comprise entre au moins une première électrode dite inférieure (Ei) à la surface d'un substrat et au moins d'une deuxième électrode dite supérieure (Es), lesdites électrodes étant isolées électriquement par une
5 couche de matériau isolant électrique pour permettre au moins une reprise de contact sur l'électrode supérieure, caractérisée en ce que le matériau isolant électrique est en matériau diélectrique amorphe de type pérovskite (DI_{am}) présentant une constante diélectrique inférieure à celle du matériau
10 cristallisé de type pérovskite.

2. Capacité intégrée selon la revendication 1, caractérisée en ce que le matériau isolant électrique est disposé sur ou sous l'électrode supérieure.

15

3. Capacité intégrée selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisée en ce que le matériau diélectrique fonctionnel cristallisé est un oxyde parmi les oxydes suivants : $Pb(Sr,Ti)O_3$, $SrTiO_3$, $(Ba,Sr)TiO_3$, $(Pb,La)(Zr,Ti)O_3$, $Pb(Mg,Nb,Ti)O_3$, $Pb(Zn,Nb,Ti)O_3$, $BiFeO_3$, $BaTiO_3$.

20

4. Capacité intégrée selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisée en ce que le matériau diélectrique isolant électrique amorphe est un oxyde parmi les oxydes suivants : PZT, $SrTiO_3$, $(Ba,Sr)TiO_3$, $(Pb,La)(Zr,Ti)O_3$, $Pb(Mg,Nb,Ti)O_3$, $Pb(Zn,Nb,Ti)O_3$, $BiFeO_3$, $BaTiO_3$.

25

5. Capacité intégrée selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisée en ce que les électrodes sont en platine ou en ruthénium, ou en oxyde de ruthénium, ou en iridium, ou en oxyde d'iridium, ou en or.

30

6. Capacité intégrée selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisée en ce que le substrat est en silicium (S_0) et comporte une couche supérieure d'oxyde (S_1).

7. Capacité intégrée selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisée en ce qu'elle comporte en outre une couche d'accrochage entre le substrat et la couche d'électrode inférieure (C_{ac}).

5 8. Capacité intégrée selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisée en ce que la reprise de contact est formée à partir d'une couche de reprise de contact (R_c) gravée, disposée au dessus de la couche de diélectrique isolant électrique et de l'électrode supérieure.

10 9. Procédé de fabrication d'une capacité intégrée selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisé en ce qu'il comprend au moins une étape de réalisation d'une couche de matériau diélectrique amorphe et isolant électrique (DI_{am}), au dessus ou au dessous de l'électrode supérieure, par procédé sol-gel comportant :

- 15 - l'étalement d'une solution sol-gel ;
 - le séchage de ladite solution à une température comprise entre environ 100°C et 150°C ;
 - la pyrolyse de ladite solution séchée à une température comprise entre environ 300°C et 500°C conduisant au matériau diélectrique isolant amorphe (DI_{am}).
- 20

10. Procédé de fabrication d'une capacité intégrée selon la revendication 9, caractérisé en ce qu'il comprend au moins une étape de réalisation d'une couche de matériau diélectrique fonctionnel cristallisé (DF_{cris}) entre l'électrode inférieure et l'électrode supérieure par procédé sol-gel comportant :

25

- l'étalement d'une solution sol-gel à la surface d'un substrat comportant une électrode inférieure ;
 - le séchage de ladite solution à une température comprise entre environ 100°C et 150°C ;
 30 - la pyrolyse de ladite solution séchée à une température comprise entre environ 300°C et 500°C conduisant à un matériau diélectrique fonctionnel amorphe;
 - la cristallisation dudit matériau fonctionnel amorphe porté à une température supérieure ou égale à la température de
- 35

cristallisation dudit matériau de manière à obtenir le matériau diélectrique fonctionnel cristallisé (DF_{cris}).

11. Procédé de fabrication d'une capacité intégrée selon la
5 revendication 10, caractérisé en ce que la cristallisation est effectuée par recuit rapide (RTA).

1/7

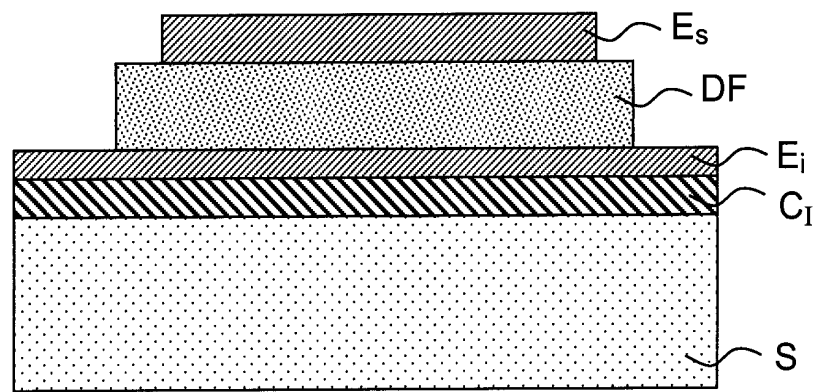


FIG. 1

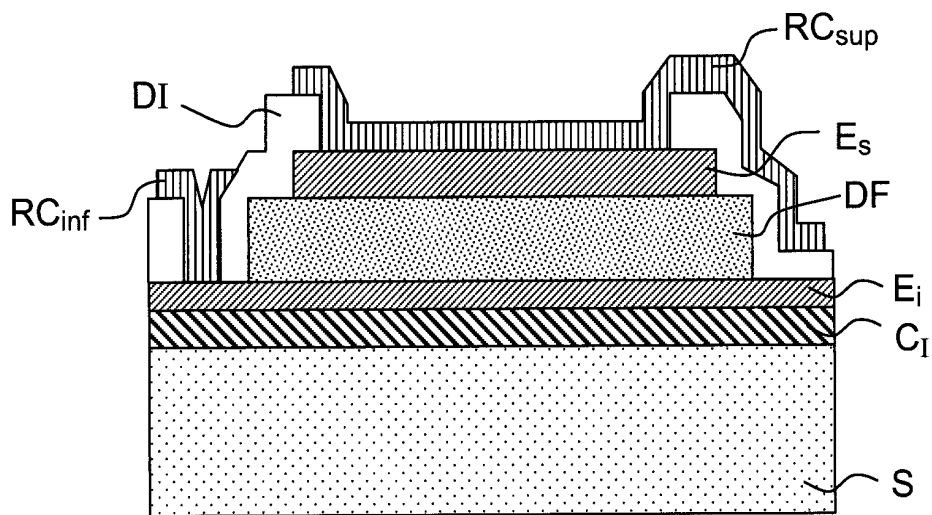


FIG. 2

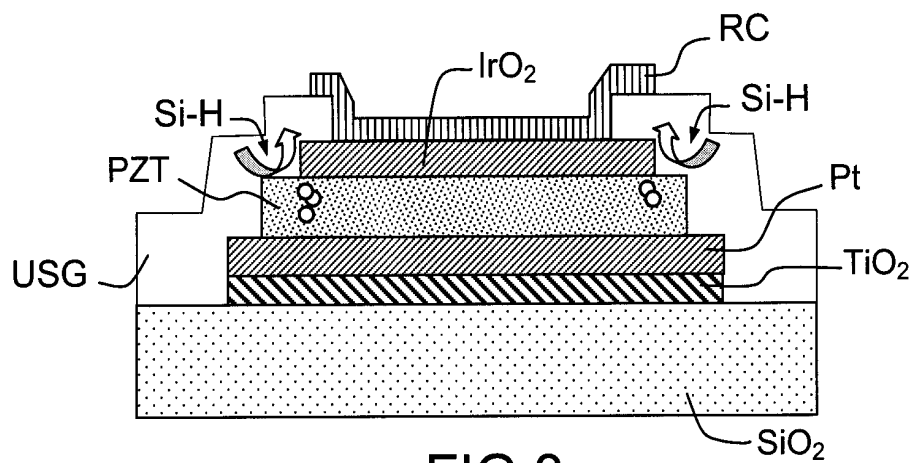


FIG. 3

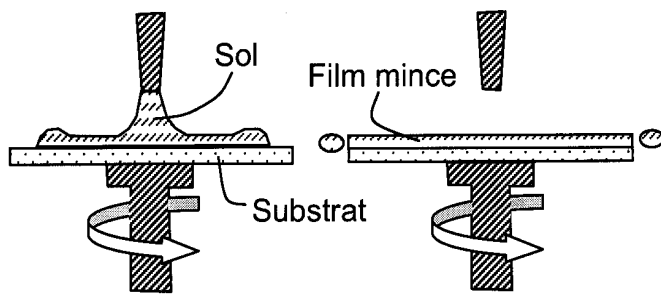


FIG. 4a

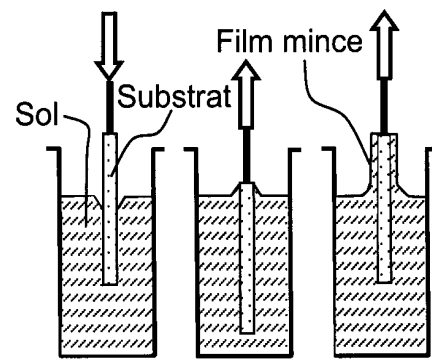


FIG. 4b

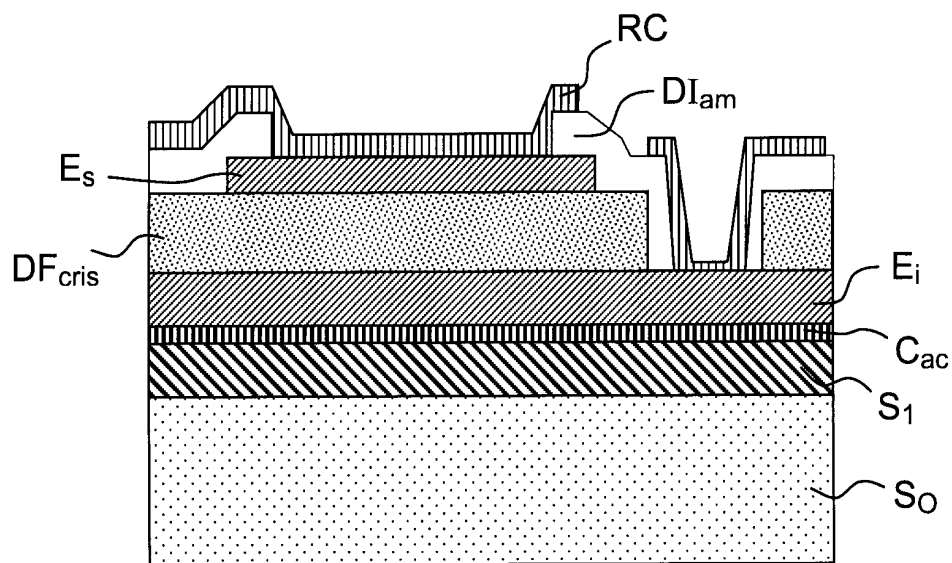


FIG. 5a

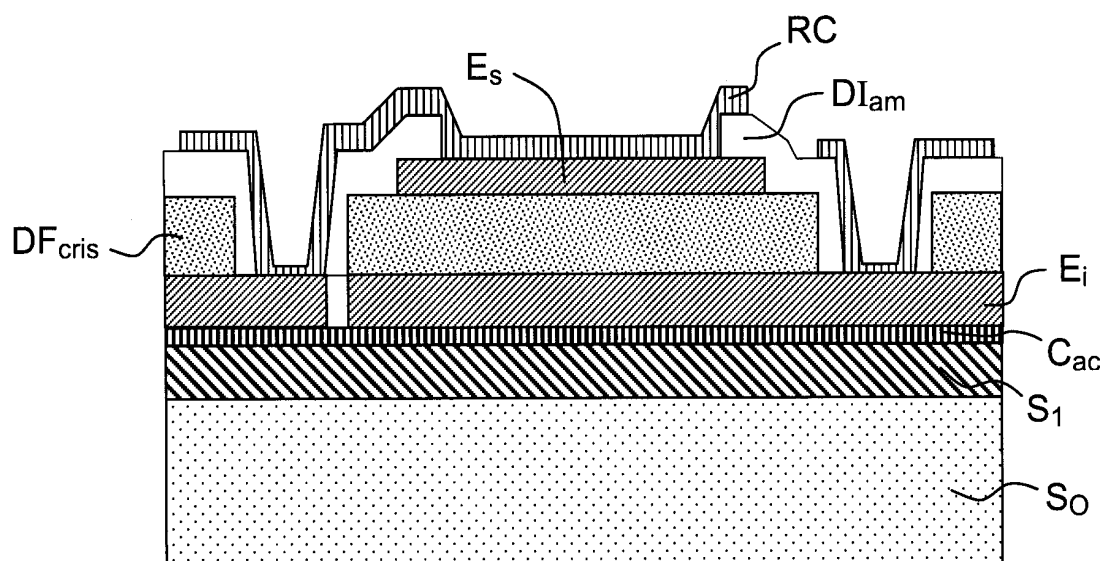


FIG. 5b

3/7

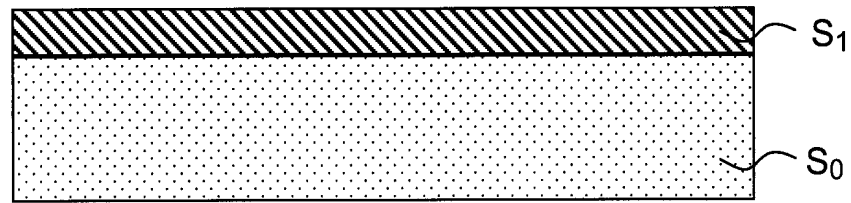


FIG.6a

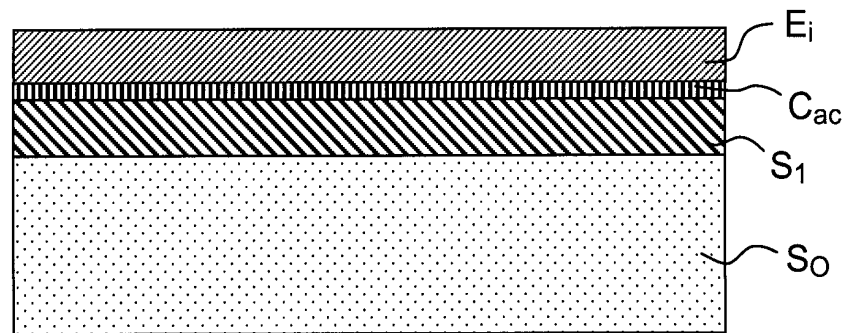


FIG.6b

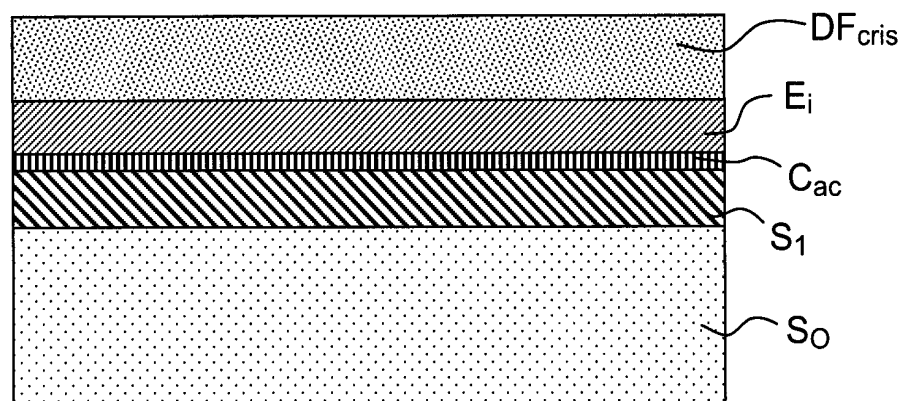


FIG.6c

4/7

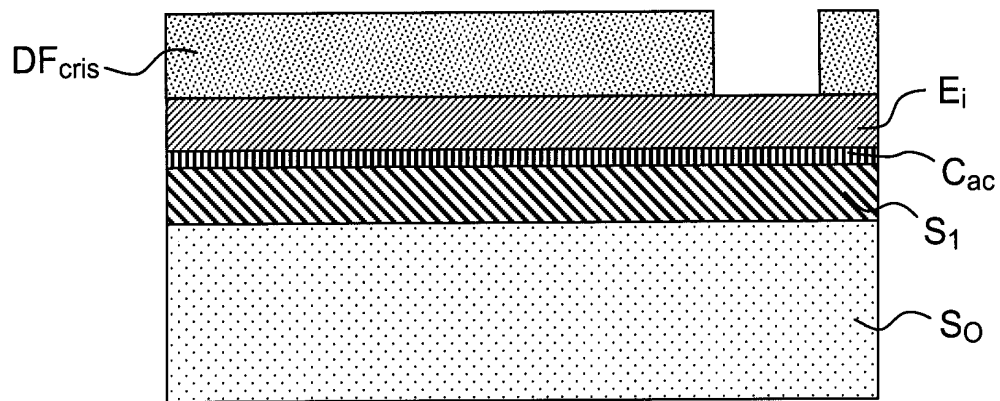


FIG. 6d

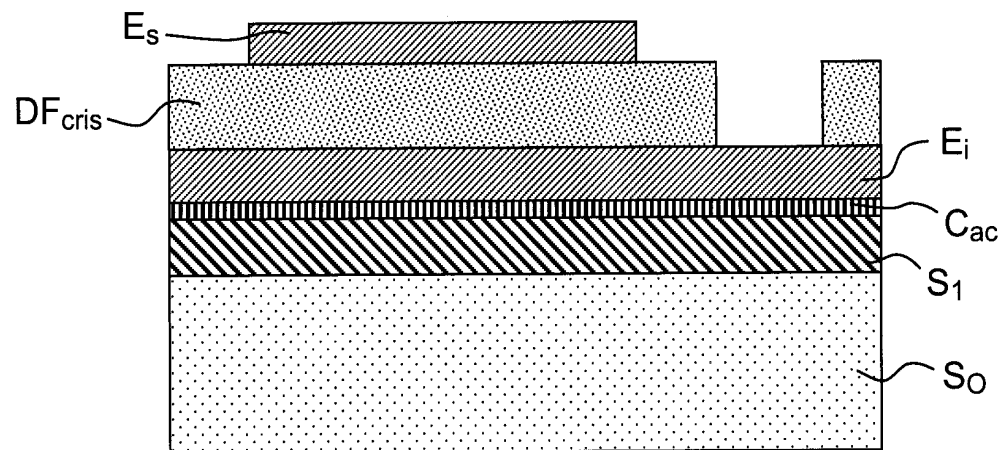


FIG. 6e

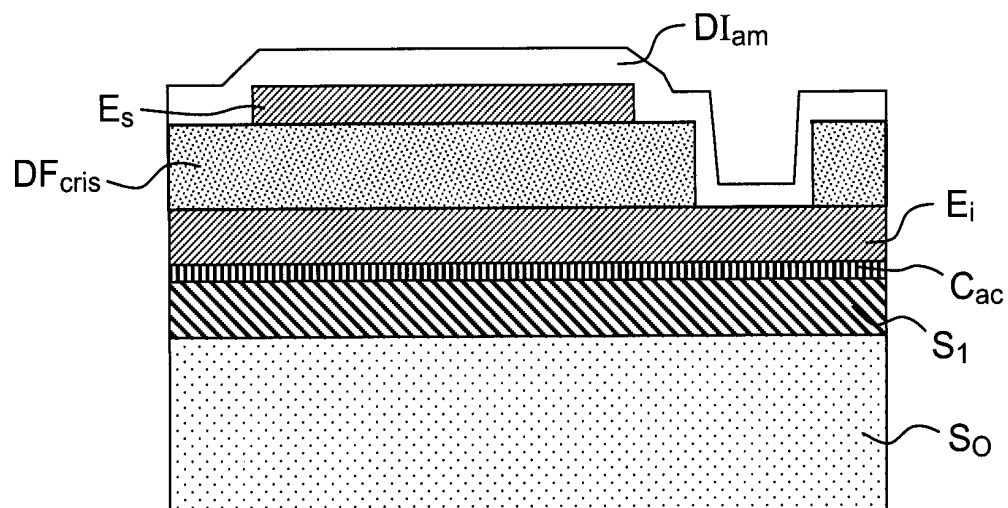


FIG. 6f

5/7

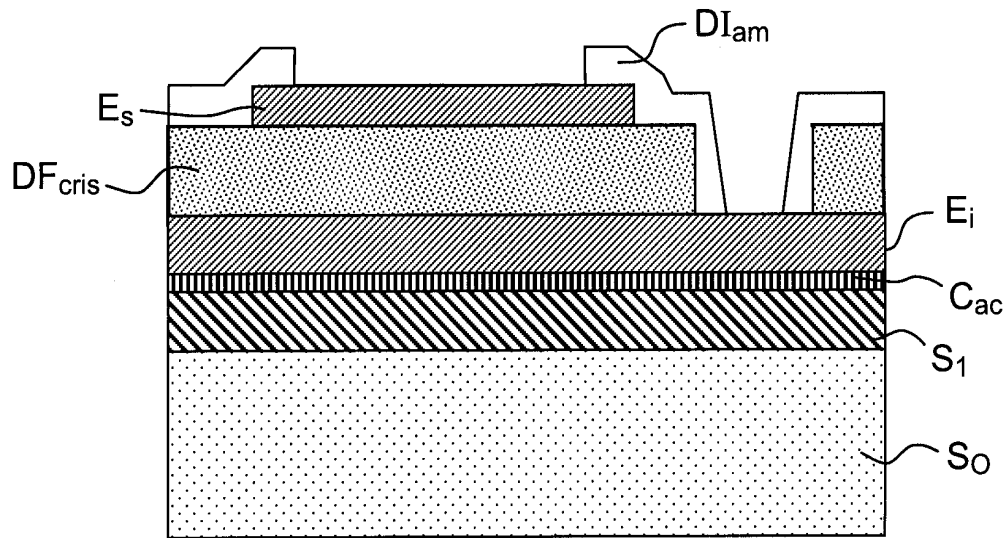


FIG. 6g

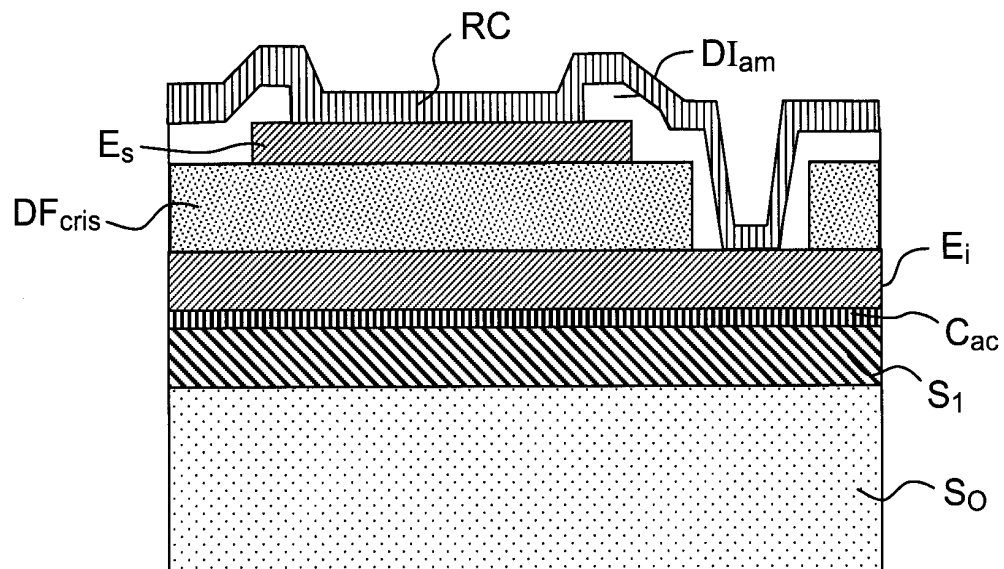


FIG. 6h

6/7

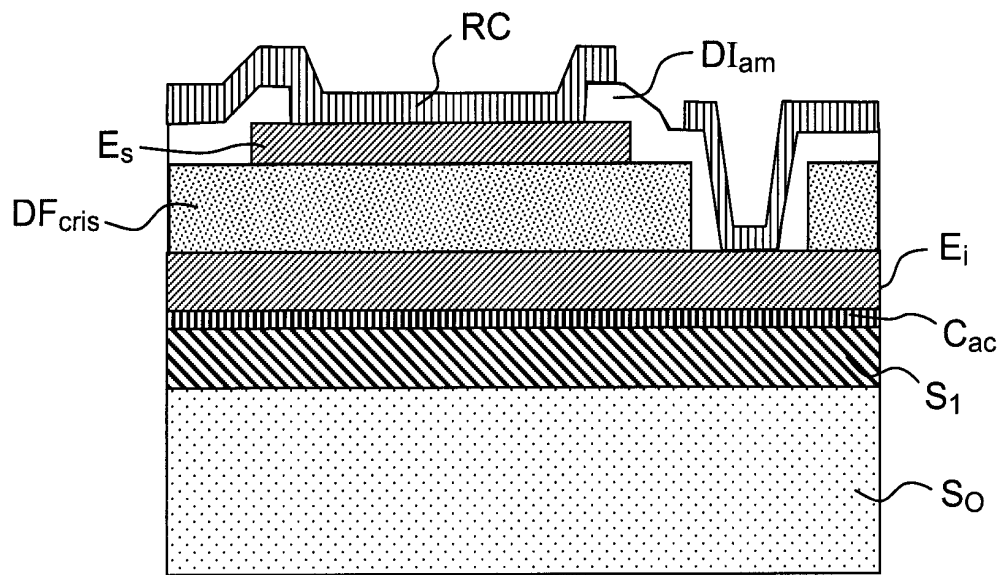


FIG. 6i

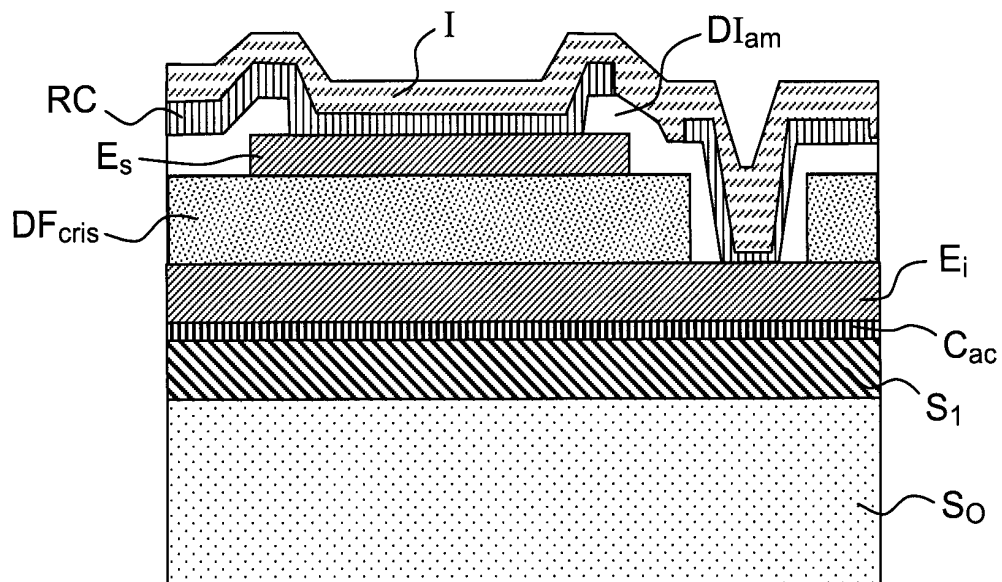


FIG. 6j

7/7

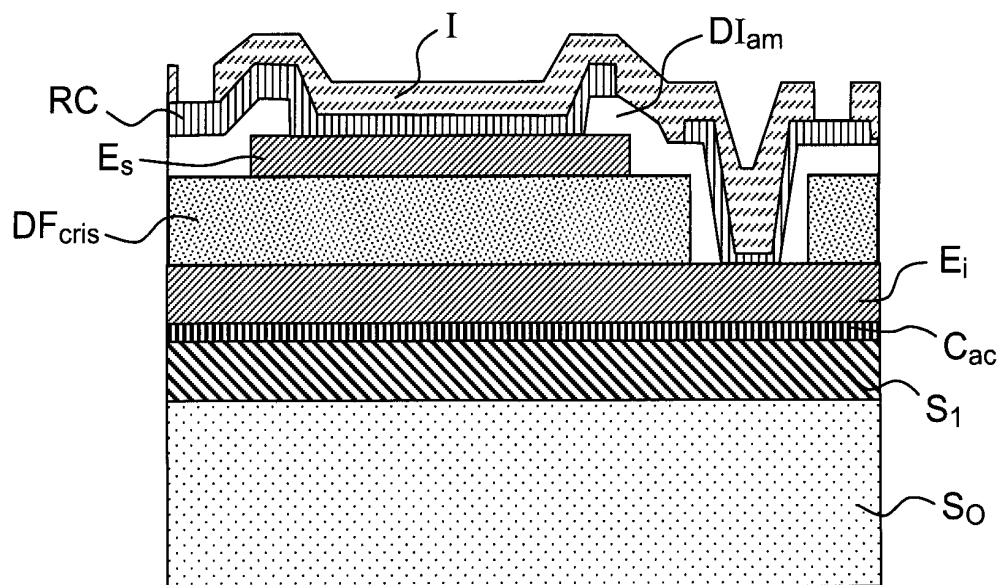


FIG.6k



RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FA 740405
FR 1003527

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
X	US 2001/001488 A1 (EASTEP BRIAN LEE [US] ET AL) 24 mai 2001 (2001-05-24)	1-8	H01L29/94 H01L29/92 H01L21/02 H01G4/33
Y	* abrégé; figures 11-17 * * alinéas [0035] - [0052] *	9-11	
X	US 2007/196932 A1 (FUJIKI MITSUSHI [JP] ET AL) 23 août 2007 (2007-08-23)	1-8	
Y	* abrégé; revendications; figures 1,2 * * alinéas [0040] - [0044], [0053] - [0059] *	9-11	
X	US 2002/175361 A1 (FOX GLEN [US] ET AL) 28 novembre 2002 (2002-11-28)	1-8	
Y	* abrégé; figures 2A-2F * * alinéas [0031] - [0038] *	9-11	
X	EP 1 217 658 A2 (FUJITSU LTD [JP]) 26 juin 2002 (2002-06-26)	1-8	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (IPC)
Y	* abrégé; figures 1-3 * * alinéas [0029] - [0040] *	9-11	
Y	XU Y ET AL: "Electrical characterizations of polycrystalline and amorphous thin films of Pb(ZrxTi1-x)O3 and BaTiO3 prepared by sol-gel technique", JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS, NORTH-HOLLAND PHYSICS PUBLISHING. AMSTERDAM, NL, vol. 176, no. 1, 2 octobre 1994 (1994-10-02), pages 1-17, XP024061984, ISSN: 0022-3093, DOI: DOI:10.1016/0022-3093(94)90205-4 [extrait le 1994-10-02] * le document en entier *	9-11	H01L
		-/--	
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
23 février 2011		Mosig, Karsten	
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant			



RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FA 740405
FR 1003527

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
Y,D	GONG W ET AL: "Effect of pyrolysis temperature on preferential orientation and electrical properties of sol-gel derived lead zirconate titanate films", JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS, BARKING, ESSEX, GB, vol. 24, no. 10-11, 1 septembre 2004 (2004-09-01), pages 2977-2982, XP004504401, ISSN: 0955-2219, DOI: DOI:10.1016/J.JEURCERAMSOC.2003.10.007 * le document en entier * -----	9-11	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (IPC)
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
23 février 2011		Mosig, Karsten	
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant	

**ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET FRANÇAIS NO. FR 1003527 FA 740405**

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche préliminaire visé ci-dessus.

Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du **23-02-2011**

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets, ni de l'Administration française

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
US 2001001488 A1	24-05-2001	AUCUN	
US 2007196932 A1	23-08-2007	JP 2007221065 A	30-08-2007
US 2002175361 A1	28-11-2002	US 2003067027 A1	10-04-2003
EP 1217658 A2	26-06-2002	CN 1371124 A	25-09-2002
		JP 4194269 B2	10-12-2008
		JP 2002246564 A	30-08-2002
		KR 20020050082 A	26-06-2002
		US 2002074601 A1	20-06-2002